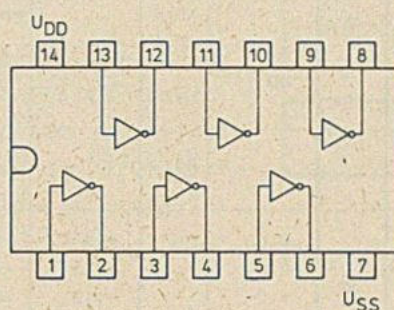


MCY 74069N
MCY 64069N
Sześciokrotny inwerter

SSI, CMOS
Bramka aluminiowa

Obudowa CE 70

Układ wyprowadzeń



74069

Parametry dopuszczalne

$U_{SS} = 0 \text{ V}$

Oznaczenie	Nazwa	Jedn.	Wartość	
			min	max
U_{DD}	Napięcie zasilania	V	-0,5	+20
U_I	Napięcie wejściowe	V	-0,5	$U_{DD} + 0,5$
I_I	Prąd wejściowy	mA	-10	+10
P_D	Moc rozpraszana	mW		500
t_{amb}	Temperatura otoczenia w czasie pracy			
	MCY 74....N	$^{\circ}\text{C}$	-40	+85
	MCY 64....N	$^{\circ}\text{C}$	0	+70
t_{stg}	Temperatura przechowywania	$^{\circ}\text{C}$	-55	+125

Parametry charakterystyczne statyczne

Ozna- czenie	Nazwa	Jedn.	Wartość						Warunki pomiaru			
			t _{amb min}		+25°C			t _{amb max}		U _I	U _O	U _{DD}
			min	max	min	typ	max	min	max	[V]	[V]	[V]
I _{DD}	Prąd zasilania w stanie spo- czyнку	μA		0,25 0,5 1 5		0,01 0,01 0,01 0,02	0,25 0,5 1 5		7,5 15 30 150	0;5 0;10 0;15 0;20		5 10 15 20
U _{IH}	Napięcie wejścio- we w stanie wyso- kim	V	4 8 12,5		4 8 12,5			4 8 12,5			0,5 1 1,5	5 10 15
U _{IL}	Napięcie wejścio- we w stanie nis- kim	V		1 2 2,5			1 2 2,5		1 2 2,5		4,5 9,0 13,5	5 10 15
I _I	Prąd wejściowy	μA		±0,1		±10 ⁻⁵	±0,1		±0,1	0;18		18
U _{OH}	Napięcie wyjścio- we w stanie wyso- kim	V	U _{DD} -0,05		U _{DD} -0,05	U _{DD}		U _{DD} -0,05		0		5;10;15
U _{OL}	Napięcie wyjścio- we w stanie nis- kim	V		0,05		0	0,05		0,05	U _{DD}		5;10;15
I _{OH}	Prąd wyjściowy w stanie wysokim	mA	-0,64 -2 -1,6 -4,2		-0,51 -1,6 -1,3 -3,4	-1 -3,2 -2,6 -6,8		-0,36 -1,15 -0,9 -2,4		0;5 0;5 0;10 0;15	4,6 2,5 9,5 13,5	5 5 10 15
I _{OL}	Prąd wyjściowy w stanie niskim	mA	0,64 1,6 4,2		0,51 1,3 3,4	1 2,6 6,8		0,36 0,9 2,4		0;5 0;10 0;15	0,4 0,5 1,5	5 10 15

$t_{amb \min} = -40^{\circ}C$ dla MCY 64.....; $0^{\circ}C$ dla MCY 74.....

$t_{amb \max} = +85^{\circ}C$ dla MCY 64.....; $+70^{\circ}C$ dla MCY 74.....

Parametry charakterystyczne dynamiczne

$t_{amb} = +25^{\circ}C$; $t_r = t_f = 20 \text{ ns}$, $C_L = 50 \text{ pF}$, $R_L = 200 \text{ k}\Omega$ /

Oznaczenie	Nazwa	Jedn.	Wartość		Warunki pomiaru U_{DD} [V]
			typ	max	
t_{PLH}	Czas propagacji zmiany stanu z niskiego na wysoki	ns	55	110	5
t_{PHL}	Czas propagacji zmiany stanu z wysokiego na niski		30	60	10
			25	50	15
t_{TLH}	Czas narastania zbocza sygnału wyjściowego	ns	100	200	5
t_{THL}	Czas opadania zbocza sygnału wyjściowego		50	100	10
			40	80	15
C_I	Pojemność wejściowa	pF	10	15	